



MOA100 系列MEMS光衰减器芯片

- ◆ 先进的硅 MEMS 器件
- ◆ 静电驱动
- ◆ 体积小
- ◆ 批量化
- ◆ 全硅结构
- ◆ 高稳定性

性能参数	单位	MOA100	
		最小	最大
镜面直径	mm	0.96	
芯片尺寸	mm	3 × 1.5 × 0.32	
镜面反射率 (1310~1620nm)	%	95	98
扭转角度	Deg	0.3	0.4
驱动电压	V	17	19
损坏电压	V	25	
谐振频率	Hz	1700	
工作温度	℃	-5	+75
存储温度	℃	40	+85

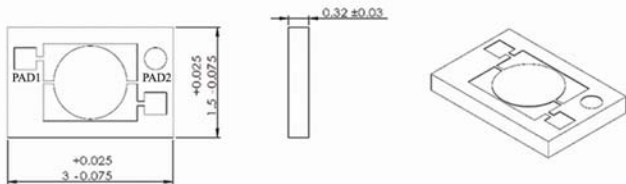
● 典型应用

OADMs
MUX/DMUX
带宽、信道均衡器
掺铒光纤放大器
光交换与光测试

● 备注

1. 测试条件（除非另有说明）：+25℃，+18Vdc。保留对产品手册进行修改且不另行通知的权利。
2. 芯片需要在高于万级净化环境中打开包装，并保存于充氮干燥箱中。
3. 打开包装后需尽快完成操作，不宜长时间暴露。
4. 芯片具有可动结构，避免用外物直接接触芯片表面。

● 外形结构及芯片键合PAD定义



PAD	定义	尺寸 (μm)
1	VDC (17~19V)	150×150
2	地	Φ100

长 × 宽 × 高 = 3.0^{+0.025}/_{-0.075} mm × 1.5^{+0.025}/_{-0.075} mm × 0.32^{+0.030}/_{-0.030} mm